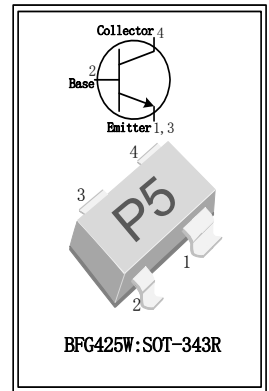


BFG425NPN TRANSISTOR (NPN)
MICROWAVE UHF LOW NOISE AMPLIFIER
NPN SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR


简述:

- 具有高功率增益放大以及低噪声特性，大动态范围，理想的电流线性；
- 主要应用于超高频微波无线射频放大、UHF 和卫星电视、CATV 高频宽带低噪声放大器等电路中；

- 集电极-基极击穿电压: $BV_{CBO} \geq 4.5V$, 集电极电流: $I_C \geq 25mA$, 集电极功率: $P_C \geq 135mW$, 特征频率: $f_T = 7GHz$;
- 可替代进口同类型号参数的高频微波低噪声晶体管；
- 封装形式: SOT-343R, 本体印字: P5。

极限参数 ($T_{amb}=25^\circ C$) :

参数名称	符号	额定值	单位
集电极-基极击穿电压	BV_{CBO}	10	V
集电极-发射极击穿电压	BV_{CEO}	4.5	V
发射极-基极击穿电压	BV_{EBO}	1	V
集电极电流	I_C	25	mA
耗散功率	P_T	135	mW
最高结温	T_J	150	$^\circ C$
储存温度	T_{stg}	-65 ~ +150	$^\circ C$

电参数及规格 ($T_{amb}=25^\circ C$) :

参数名称	符号	测试条件	额定值			单位
			最小值	典型值	最大值	
集电极-基极击穿电压	BV_{CBO}	$I_C=2.5\mu A, I_E=0 mA$	10	-	-	V
集电极-发射极击穿电压	BV_{CEO}	$I_C=1.0mA, I_B=0 mA$	4.5	-	-	V
发射极-基极击穿电压	BV_{EBO}	$I_E=2.5\mu A, I_C=0 mA$	1	-	-	V
集电极截止电流	I_{CBO}	$V_{CB}=4.5V, I_E=0 mA$	-	-	15	nA
发射极截止电流	I_{EBO}	$V_{EB}=1.0V, I_C=0 mA$	-	-	15	nA
直流电流放大系数	h_{FE}	$V_{CE}=2V, I_C=25mA$	50	80	120	
特征频率	f_T	$V_{CE}=2V, I_C=25mA, f=2GHz$	-	25	-	GHz
反馈电容	C_{re}	$I_E=0 mA, V_{CB}=2V, f=1MHz$	95	105	-	fF
插入功率增益	$ S_{21e} ^2$	$I_C=25mA, V_{CE}=2V, f=2GHz$	16	17	-	dB
噪声系数	NF	$V_{CE}=2V, I_C=2mA, f=900MHz$	-	0.8	-	dB
		$V_{CE}=2V, I_C=2mA, f=2GHz$	-	1.2	2.0	dB

TYPICAL CHARACTERISTICS
($T_A=25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)

